(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-320634

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

(51)Int.CL⁵

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 K 11/06

Z 9159-4H

H 0 5 B 33/14

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-132214

(71)出願人 000002093

住友化学工業株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992) 5月25日

大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号

(72)発明者 大西 敏博

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式

会社内

(72)発明者 野口 公信

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式

会社内

(72)発明者 桑原 真人

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式

会社内

(74)代理人 弁理士 諸石 光▲ひろ▼ (外1名)

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【目的】耐熱性と発光の均一性の良好な有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【構成】少なくとも一方が透明または半透明である一対の電極間に、発光材料を含む発光層と正孔輸送材料を含む正孔輸送層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該正孔輸送材料として4,4'ービス(N,N-ジピリジルアミノ)ビフェニルを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明である一対の電極間に、発光材料を含む発光層と正孔輸送材料を含む正孔輸送材料と発光材料を含*

* む発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子に おいて、該正孔輸送材料として下記化1 【化1】

$$(R_1)_{\text{IN}} \qquad (R_2)_{\text{IN}} \qquad (R_3)_{\text{IN}} \qquad (R_4)_{\text{O}}$$

(ここでR1、R2、R3、R4 は置換基でそれぞれ独立に炭素数1~12のアルキルまたはアルコキシ基、炭素数6以上の芳香族炭化水素基、または炭素数4以上の芳香族性複素環化合物基で、同一のピリジン環に複数の置換基があるときにはそれらは同一であっても異なっていてもよい。また1、m、n、oはそれぞれ独立に0~4の整数を示す。)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から用いられている無機エレクトロ ルミネッセンス素子 (以下無機EL素子) は、発光させ るのに高電圧が必要であった。最近、C. W. Tang らは、有機蛍光色素を発光層とし、電子写真の感光体等 に用いられていた有機電荷輸送性化合物とを積層した、 二層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子 (以下有機E L素子)を作製し、低電圧駆動,高効率, 高輝度の有機EL素子を実現させた(特開昭59-19 4393号公報)。有機EL素子は、無機EL素子に比 べ、低電圧駆動、高輝度、加えて、多数の色の発光が容 易に得られる、という特長があることから、素子構造や 有機蛍光色素,有機電荷輸送性化合物について、多くの 試みが報告されている(ジャパニーズ・ジャーナル・オ ブ・アプライド・フィジックス (Jpn. J. App 1. Phys.) 27巻、L269(1988))、 (ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス (J. Appl. Phys.)第65卷、3610頁(198% **※9))**。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】有機正孔輸送材料として、ビフェニルを骨格に持つ芳香族アミノ化合物、例えば4,4'ービス(Nー(3ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノ)ビフェニル(以下TPD)は、有機E L素子の正孔輸送材料として利用されている。しかしながら、TPDを正孔輸送材料として使用した有機E L素子は寿命が短いという問題がある。これは素子の発熱により、有機層の構造変化が生じ、劣化するとため言われている。したがって、熱的に安定な有機層を構成する正孔輸送材料が求められていた。

【0004】本発明の目的は、耐熱性の向上した有機E L素子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機EL素子の耐熱性向上を鋭意検討してきた。その結果、正孔 動送材料として、ビフェニルを骨格に持つ、芳香属アミノ化合物のなかで、4,4'ービス(N,Nージビリジルアミノ)ビフェニル及びその誘導体化合物を用いることにより、均一な有機膜を形成し、有機EL素子の熱的安定性が改良されることを見い出し、本発明に至った。すなわち、本発明は、少なくとも一方が透明または半透明である一対の電極間に、発光材料を含む発光層と正孔輸送材料を含む発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該正孔輸送材料として下記化2

40 [0006]

【化2】

$$(R_1)_1$$
 N
 N
 N
 $(R_2)_m$
 $(R_4)_0$

(ここでR₁、R₂、R₃、R₄ は置換基でそれぞれ独 立に炭素数1~12のアルキルまたはアルコキシ基、炭 素数6以上の芳香族炭化水素基、または炭素数4以上の ヘテロ原子を含有する芳香族性複素環化合物基で、同一 のビリジン環に複数の置換基があるときにはそれらは同 一であっても異なっていてもよい。また1、m、n、o はそれぞれ独立に0~4の整数を示す。)で表される化 合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネ ッセンス素子を提供することにある。

【0007】以下、本発明によるEL素子について詳細 10 に説明する。本発明に用いられる、正孔輸送材料は上記 化2で表される化合物である。ここで、置換基R1 、R 2 、R3 、R4 はそれぞれ異なる基であることも可能で あるが、合成の容易さより、2つ以上の基が同一である ことが好ましい。

【0008】 炭素数 1~12のアルキル基としては、例 えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、 ヘキシル、ヘプチル、オクチル、デシルなどであり、メ チル、エチルが好ましい。また炭素数1~12のアルコ キシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブ 20 トキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオ キシ、オクチルオキシ、デシルオキシなどであり、メト キシ、エトキシが好ましい。炭素数が6以上(好ましく は6~14)の芳香族炭化水素基としてはフェニル、5 ーアルコキシフェニル基、4ーアルコキシフェニル基、 5-アルキルフェニル基、4-アルキルフェニル基、1 ーナフタレン基、2ーナフタレン基が例示される。ここ で4-位または5-位のアルキルまたはアルコキシ置換 基は前記R1 、R2 、R3 、R4 で定義したアルキルま ましい。 炭素数が4以上 (好ましくは4~12) の芳香 族性複素環化合物基としてはチオフェンー2-イル、ビ リジン-2-イル基、ピリジン-3-イル基、ピリジン -4-イル基が例示される。

【0009】具体的な化合物として、4,4'ービス (N, N-ジピリジルアミノ) ビフェニル、4,4'-ビス (N-(3-メチルピリジル) -N-ピリジルアミ ノ) ビフェニル、4,4'ービス (Nー (3ーメトキシ ピリジル) -N-ピリジルアミノ) ビフェニル、4, 4'-ビス(N, N-ジ(3-メチルピリジル)アミ ノ) ビフェニル、4,4'ービス (N, Nービス (3-メトキシピリジル) アミノ) ビフェニル、4-(N, N ージピリジルアミノ) -4'-(N, N-ビス (3-メ チルピリジルアミノ)) ピフェニル、4-(N, N-ジ ピリジルアミノ) -4' - (N' - (3-メチルピリジ ル) ビフェニルなどが例示される。

【0010】本発明に使用の化2で示される化合物の合 成法は特に限定されず、例えば、4,4'ージヨードビ フェニルに、相当するアミンを反応させて合成する等公 知の反応を利用することができる。また、これらの化合 50 る吸収が強くないものが好適に用いられる。ポリ(N-

物を有機EL素子の正孔輸送材料として用いる場合、そ の純度が発光特性に影響を与えるため、合成後、再沈精 製、昇華精製等の純化をすることが望ましい。

【0011】本発明においては、本発明の目的を損なわ ない範囲で化2で示される化合物を既知の電荷輸送材料 (正孔輸送材料と電子輸送材料の総称) に分散させて用 いることも可能である。既知の電荷輸送材料としては特 に限定はされないが、例えば、トリフェニルジアミン誘 導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、ア リールアミン誘導体、スチルベン誘導体などを用いるこ とができる。 化2で示される化合物と既知の電荷輸送材 料の混合比は特に限定されないが、好ましくは重量で既 知の電荷輸送性材料100に対して化2で示される化合 物が5以上であり、より好ましくは40以上、さらに好

ましくは80以上の範囲である。

【0012】また本発明には、化2で示される化合物 を、既知の高分子を媒体としてこれに分散した層として 用いることも含まれる。高分子化合物としては、特に限 定されないが、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ま しく、例えば、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、ポリ アニリン及びその誘導体、ポリチオフェン及びその誘導 体、ポリ (p-フェニレンビニレン) 及びその誘導体、 ポリ(2,5-チエニレンビニレン)及びその誘導体、 ポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリメチルメ タクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシ ロキサンなどが例示される。なお、ポリ(Nービニルカ ルバゾール)、ポリアニリン及びその誘導体、ポリチオ フェン及びその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレ ン)及びその誘導体、ポリ(2,5-チエニレンビニレ たはアルコキシ基が例示され、特にメチル、エチルが好 30 ン)及びその誘導体などは正孔輸送材料としての作用も 有する。

> 【0013】本発明において発光層として使用する発光 材料は特に限定されず、例えば、ナフタレン誘導体、ア ントラセン誘導体、ペリレン誘導体、ポリメチン系、キ サンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8 ーヒドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体、芳 香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン誘導 体、テトラフェニルブタジエン誘導体など特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載され 40 ているもの等、公知のものが使用可能である。

【0014】さらに、特公平3-71453号公報記載 の共役鎖長の短いポリ(p-フェニレンビニレン)、ポ リ(2,5ージヘプチルオキシーpーフェニレンビニレ ン) などの共役系高分子も発光材料として用いることが できる。 また、 本発明においては、 化2で示される化合 物と上記発光材料との混合物を発光層として用いること もでき、さらにこれらを既知の高分子を媒体としてこれ に分散した層として用いることも含まれる。高分子化合 物は前述のものを用いることができるが、可視光に対す ビニルカルバゾール)、ポリチオフェン及びその誘導体、ポリ (p-フェニレンビニレン)及びその誘導体、ポリ (2,5-チエニレンビニレン)及びその誘導体、ポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサンなどが例示される。また、これらの層を一層のみで使用する場合は公知の電子輸送材料を併用することもできる。公知の電子輸送材料としては、アントラキノジメタン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、オキサジアゾール誘導体などが例示される。

【0015】本発明の有機EL素子の代表的な構造について以下に述べる。素子の構造としては、これまで述べた陽極/正孔輸送層/発光層/陰極(/は層を積層したことを示す)、あるいは陽極/正孔輸送材料・発光材料の混合層/陰極の構造以外に、発光層と陰極との間に公知の電子輸送層を有する組み合わせの構造すなわち陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極の構造をとることもできる。また陽極と電荷輸送層との間に導電性高分子層を有する組み合わせの構造をとることもできる。すなわち陽極/導電性高分子/正孔輸送層/発光層/陰極、もしくは陽極/導電性高分子/正孔輸送層/発光層/陰極、もしくは陽極/導電性高分子/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極の構造をとることもできる。

【0016】これらの中で好ましい素子構造は、陽極/ 正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極の構造もしく は、陽極/導電性高分子/正孔輸送層/発光層/電子輸 送層/陰極の構造である。

【0017】本発明のEL素子の構造について以下に述べる。一対の電極で透明、または半透明な電極としては 30 ガラス、透明プラスチック等の透明基板の上に透明または半透明電極を形成する。電極の材料としては導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的にはインジウム・スズ・オキサイド(ITO)、酸化スズ(NESA)、Au、Pt、Ag、Cu等が用いられる。作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、メッキ法などが用いられる。

【0018】次いで、この電極上に正孔輸送層として本発明における正孔輸送材料の単独層、これと高分子媒体との混合層、あるいは本発明における正孔輸送材料と発 40 光材料および高分子媒体との混合層(この場合は発光層を兼ねる)を形成する。形成方法としては、単独層では粉末状態からの真空蒸着法、あるいは溶液に溶かした後のスピンコーテイング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法が例示され、高分子媒体との混合層では溶液状態または溶融状態で混合し分散させた後のスピンコーテイング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法などの塗布法を用いることができる。単独層においては、膜厚の微妙な制御を行なうという点では、50

真空蒸着法を用いることが好ましい。

【0019】上記正孔輪送層の膜厚としては0.5nm~10μm、好ましくは1nm~1μmである。電流密度を上げて発光効率を上げるためには2nm~200nmの範囲が好ましい。なお、塗布法により薄膜化した場合には、溶媒を除去するため、減圧下あるいは不活性雰囲気下、30~300℃、好ましくは60~200℃の温度で熱処理することが望ましい。

【0020】なお、上記の正孔輸送層が発光材料を含ま 10 ない場合にはその上に発光層を形成する。発光層の成膜 方法としては、特に限定されず、上記正孔輸送層の単独 層と同様な方法を採用することができる。膜厚の微妙な 制御を行なうという点では、真空蒸着法を用いることが 好ましい。

【0021】発光層の膜厚は、少なくともピンホールが発生しないような厚みが必要であるが、あまり厚いと素子の抵抗が増加し、高い駆動電圧が必要となり好ましくない。したがって、発光層の膜厚は0.5nm~10μm、好ましくは1nm~1μm、さらに好ましくは5~200nmである。

【0022】次いで、正孔輸送層/発光層の積層上、あるいは電荷輸送材料・発光材料混合層上に電極を設ける。この電極は電子注入陰極となる。その材料としては、特に限定されないが、イオン化エネルギーの小さい材料が好ましい。例えば、Al、In、Mg、Mg-Ag合金、In-Ag合金、Mg-In合金、Caおよびそれらの合金、Liおよびそれらの合金、グラファイト薄膜等が用いられる。陰極の作製方法としては真空蒸着法、スパッタリング法等が用いられる。

30 [0023]

【実施例】以下本発明の実施例を示すが、本発明はこれ らに限定されるものではない。

【0024】実施例1

スパッタリングによって、20nmの厚みでITO膜を 付けたガラス基板に、正孔輸送層として、4,4'-ビ ス (N, N-ジピリジルアミノ) ピフェニル (以下BD PAと略記する)を3×10⁻⁶Torrの真空下で、蒸 着により60 nmの厚みで成膜した。次いで、その上 に、発光層として、トリス (8-キノリノール) アルミ ニウム (A 1 q3)を40 nm、更に、その上に陰極と して、インジウムを600mm蒸着して、有機EL素子 を作製した。これらの各層の蒸着は、真空を破ることな く減圧下、連続して行った。蒸着のときの真空度はすべ て3×10-6Torr以下であった。この素子に電圧2 7Vを印加したところ電流密度44mA/cm²の電流 が流れ、輝度175cd/m²の緑色のEL発光が観察 された。輝度は電流密度に比例していた。この素子を加 熱恒温漕に入れ、昇温しながら、EL発光の変化を観察 した。BDPAを用いた素子は100℃を超えた状態に 50 おいても、輝度の低下はゆるやかなものに抑えられ、発

8

[0027]

7

光し続けた。

【0025】実施例2

スパッタリングによって、40nmの厚みでITO膜を 付けたガラス基板に、正孔輸送層として、BDPAを3 ×10-6Torrの真空下で、蒸着により50nmの厚 みで成膜した。次いで、その上に、発光層として、A1 q3 を100nm、更に、その上に陰極として、マグネ シウム・銀合金を150nm (マグネシウム:銀は重量 比で10:1) 蒸着して有機EL素子を作製した。これ て行った。蒸着のときの真空度はすべて3×10-6To rr以下であった。この素子に電圧33Vを印加したと ころ電流密度137mA/cm²の電流が流れ、輝度2 000cd/m²の緑色のEL発光が観察された。輝度 は電流密度に比例していた。この素子を加熱恒温漕に入 れ、昇温しながら、EL発光の変化を観察した。BDP Aを用いた素子は100℃を超えた状態においても、輝 度の低下はゆるやかなものに抑えられ、発光し続けた。 【0026】比較例1

スパッタリングによって、20nmの厚みでITO膜を 20

付けたガラス基板に、正孔輸送層として、4,4'ービ ス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ) ビフェニル (TPD) を3×10-6Torrの真空 下で、蒸着により50 nmの厚みで成膜した。次いで、 その上に、発光層として、A1g3を80nm、更に、 その上に陰極として、インジウムを600nm蒸着し て、有機EL素子を作製した。これらの各層の蒸着は、 真空を破ることなく減圧下、連続して行った。蒸着のと きの真空度はすべて3 ×10-6Torr以下であった。 らの各層の蒸着は、真空を破ることなく減圧下,連続し 10 この素子を加熱恒温漕に入れ、昇温しながら、EL発光 の変化を観察した。TPDを用いた素子は、80℃を超 えると急激に輝度が低下し、発光が見られなくなった。

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明の有機EL 素子は、従来のものに比較して熱的安定性が向上し、発 光素子の寿命の延長を図ることができ、また、本発明に よるEL素子により、バックライトとしての面状光源、 フラットパネルディスプレイ等の装置としての使用が可 能となる。